

シリコンPNPエピタキシャル形トランジスタ(PCT方式)  
SILICON PNP EPITAXIAL TRANSISTOR (PCT PROCESS)

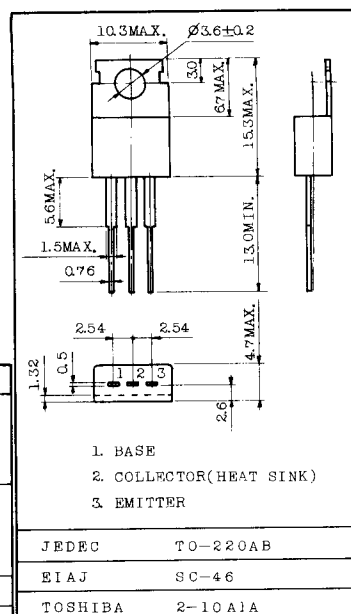
2SA968・2SA968A  
2SA968B

- 電力増幅率
- 励振段電力増幅用
- Power Amplifier Applications.
- Driver Stage Amplifier Applications.

- ・ トランジション周波数が高い。:  $f_T=100\text{MHz}$  (Typ.)
- ・ 2SC2238 とコンプリメンタリになります。
- ・ Can Type (TO-66) の 2SA969 もあります。
- ・ Complementary to 2SC2238.

最大定格 MAXIMUM RATINGS ( $T_a=25^\circ\text{C}$ )

| CHARACTERISTIC                    | SYMBOL    | RATING  | UNIT             |
|-----------------------------------|-----------|---------|------------------|
| コレクタ・ベース間電圧                       | 2SA968    | -160    | V                |
|                                   | 2SA968A   | -180    |                  |
|                                   | 2SA968B   | -200    |                  |
| コレクタ・エミッタ間電圧                      | 2SA968    | -160    | V                |
|                                   | 2SA968A   | -180    |                  |
|                                   | 2SA968B   | -200    |                  |
| エミッタ・ベース間電圧                       | $V_{EB0}$ | -5      | V                |
| コレクタ電流                            | $I_C$     | -1.5    | A                |
| エミッタ電流                            | $I_E$     | 1.5     | A                |
| コレクタ損失 ( $T_c=25^\circ\text{C}$ ) | $P_C$     | 25      | W                |
| 接合温度                              | $T_j$     | 150     | $^\circ\text{C}$ |
| 保存温度                              | $T_{stg}$ | -55~150 | $^\circ\text{C}$ |



アクセサリは AC75 を適用  
MOUNTING KIT No. AC75

電気的特性 ELECTRICAL CHARACTERISTICS ( $T_a=25^\circ\text{C}$ )

| CHARACTERISTIC | SYMBOL             | CONDITION                                  | MIN. | TYP. | MAX. | UNIT          |
|----------------|--------------------|--------------------------------------------|------|------|------|---------------|
| コレクタしゅ断電流      | $I_{CBO}$          | $V_{CB}=-160\text{V}, I_E=0$               | —    | —    | -1.0 | $\mu\text{A}$ |
| エミッタしゅ断電流      | $I_{EBO}$          | $V_{EB}=-5\text{V}, I_C=0$                 | —    | —    | -1.0 | $\mu\text{A}$ |
| コレクタ・エミッタ間降伏電圧 | 2SA968             | $I_C=-10\text{mA}, I_B=0$                  | -160 | —    | —    | V             |
|                | 2SA968A            |                                            | -180 | —    | —    |               |
|                | 2SA968B            |                                            | -200 | —    | —    |               |
| エミッタ・ベース間降伏電圧  | $V_{(BR)EBO}$      | $I_E=-1\text{mA}, I_C=0$                   | -5   | —    | —    | V             |
| 直流電流増幅率        | $h_{FE}$<br>(Note) | $V_{CE}=-5\text{V}, I_C=-100\text{mA}$     | 70   | —    | 240  |               |
| コレクタ・エミッタ間飽和電圧 | $V_{CE(sat)}$      | $I_C=-500\text{mA}, I_B=-50\text{mA}$      | —    | —    | -1.5 | V             |
| ベース・エミッタ間電圧    | $V_{BE}$           | $V_{CE}=-5\text{V}, I_C=-500\text{mA}$     | —    | —    | -1.0 | V             |
| トランジション周波数     | $f_T$              | $V_{CE}=-10\text{V}, I_C=-100\text{mA}$    | —    | 100  | —    | MHz           |
| コレクタ出力容量       | $C_{ob}$           | $V_{CB}=-10\text{V}, I_C=0, f=1\text{MHz}$ | —    | 30   | —    | pF            |

Note:  $h_{FE}$  区分/ $h_{FE}$  classification O: 70~140, Y: 120~240